

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-291048

(43)公開日 平成6年(1994)10月16日

(51)Int.Cl.  
H 01 L 21/205  
C 23 C 16/50識別記号 序内整理番号  
F I  
6116-4K

技術表示箇所

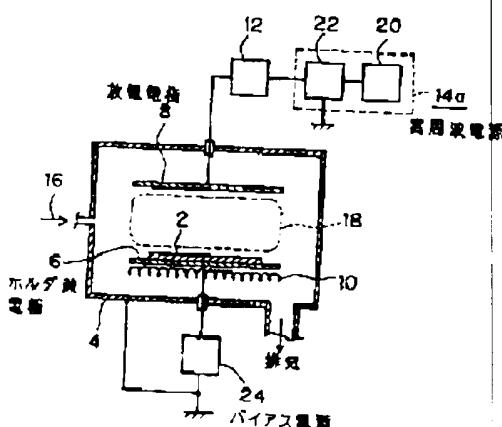
		審査請求 有	請求項の数 2 FD (全 4 頁)
(21)出願番号	特願平4-200220	(71)出願人	000003942
(22)出願日	平成4年(1992)7月2日	日新電機株式会社	京都府京都市右京区梅津高畠町47番地
		(72)発明者	柳村 洋哉 京都府京都市右京区梅津高畠町47番地 新電機株式会社内
		(72)発明者	桑原 剛 京都府京都市右京区梅津高畠町47番地 新電機株式会社内
		(74)代理人	弁理士 山本 康二

## (54)【発明の名称】 薄膜形成方法

## (57)【要約】

【目的】 プラズマCVD法によるものであって、パーティクルの発生を抑制し、かつ低温成膜においても膜の結晶化を促進させることができる薄膜形成方法を提供する。

【構成】 放電電極8とホルダ兼電極6との間に、高周波電源14aから、元となる高周波信号に対してそれを断続させる変調をかけた高周波電力を供給する。かつ、ホルダ兼電極6に、バイアス電源24から、上記高周波電力の断続に向随して断続する旨のバイアス電圧を印加する。



(2)

特開平6-291048

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基体を保持するホルダ兼電極とこれに対する放電電極との間の高周波放電によってプラズマを発生させるプラズマCVD法によって基体の表面に薄膜を形成する薄膜形成方法において、前記放電電極とホルダ兼電極との間に、元となる高周波信号に対してそれを断続させる変調をかけた高周波電力を供給すると共に、前記ホルダ兼電極に、当該高周波電力の断続に同期して断続する負のバイアス電圧を印加することを特徴とする薄膜形成方法。

【請求項2】 前記高周波電力の変調の周波数が100Hz～1KHzの範囲内、デューティー比が10～90%の範囲内にあり、前記バイアス電圧のオン期間が前記高周波電力のオン期間内にあり、かつ前記高周波電力のオン時点から前記バイアス電圧のオン時点までの遅延時間が前記高周波電力のオン期間の10～90%の範囲内にある請求項1記載の薄膜形成方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【産業上の利用分野】 この発明は、高周波放電を用いたプラズマCVD法によって、基体の表面に例えばシリコン膜等の薄膜を形成する薄膜形成方法に関する。

## 【0002】

【従来の技術】 図3は、従来のプラズマCVD装置の一例を示す概略図である。この装置は、いわゆる平行平板型（別名、空疇結合型）のものであり、図示しない真空排気装置によって真空排気される真空容器4内に、成膜しようとする基体（例えば基板）2を保持するホルダ兼電極6と放電電極8とを対向させて収納している。ホルダ兼電極6上の基体2は例えばヒータ10によって加熱される。

【0003】 ホルダ兼電極6は接地されており、放電電極8にはマッチングボックス12を介して高周波電源14が接続されており、この高周波電源14から両電極6、8間に高周波電力が供給される。この高周波電力は、従来は連続した正弦波であり、その周波数は通常は13.56MHzである。

【0004】 このような装置において、真空容器4を真空排気すると共にそこに所要の原料ガス（例えばシラン（SiH<sub>4</sub>）ガスと水素（H<sub>2</sub>）ガスとの混合ガス）を導入し、かつ電極6、8間に高周波電源14から高周波電力を供給すると、両電極6、8間に高周波放電が生じて原料ガス16がプラズマ化され（18はそのプラズマを示す）、これによって基体2の表面に薄膜（例えばシリコン薄膜）が形成される。

## 【0005】

【発明が解決する課題】 本発明は、

（1）上述の従来の装置における薄膜形成が困難である。

（2）上述の従来の装置における高周波電力と

（3）上述の従来の装置における基板の取扱いが難しくなる点であるから、

けその中のラジカル（活性種）の制御ができず、従って、CVD法で問題となる、不要なラジカルの生成に伴うパーティクル（粉塵）の発生を抑制することができない。

【0007】 ② プラズマ18中の負荷電粒子が集まつてそれがパーティクルとして基体2に付着するのを抑制することができない。

【0008】 ③ 低温成膜においては、基体2の表面に形成される膜の結晶化を起こすためのエネルギーが膜に十分に与えられないので、膜の結晶化が期待できない。結晶化膜を得るためにには、成膜後、高温アニール、レーザーアニール等の熱処理が必要になり、そのぶん工程が増える。

【0009】 そこでこの発明は、プラズマCVD法によるものであって、パーティクルの発生を抑制し、かつ低温成膜においても膜の結晶化を促進させることができる薄膜形成方法を提供することを主たる目的とする。

## 【0010】

【課題を解決するための手段】 上記目的を達成するため、この発明の薄膜形成方法は、前記放電電極とホルダ兼電極との間に、元となる高周波信号に対してそれを断続させる変調をかけた高周波電力を供給すると共に、前記ホルダ兼電極に、当該高周波電力の断続に同期して断続する負のバイアス電圧を印加することを特徴とする。

## 【0011】

【作用】 プラズマ中には、良質な膜を形成するのに寄与するラジカルと、膜形成に必要でパーティクルの原因となるラジカルとが混在する。一般的に、前者は寿命が比較的長く、後者は寿命が比較的短い。そこで上記のように、断続変調をかけた高周波電力を用いることにより、良質な膜形成に寄与するラジカルの優先生成および不必要的ラジカルの抑制が可能になり、これによってパーティクルの発生を抑制することができる。

【0012】 また、ホルダ兼電極に上記のように負のバイアス電圧を印加することにより、基体の表面近傍にできるシース領域内のイオンがバイアス電圧によって加速されて基体表面に衝突するので、そのエネルギーによって、低品質膜においても、膜の結晶化を促進させることができる。

## 【0013】

【実施例】 図1は、この発明の実施に用いたプラズマCVD装置の一例を示す概略図である。図3の従来例と同一または相当する部分には同一符号を付し、以下においては当該従来例との相違点を主に説明する。

【0014】 この実施例においては、従来の高周波電源

14に代えて、任意の波形（基周波数13.56MHz）

の周波数で供給する高周波電源14を用いて構成

された高周波電源14を用いている。そしてこれによつて、例えば図2に示すように、元となる高周波信号に



コン膜が形成できた。  
【0036】

【発明の効果】以上のようにこの発明によれば、上記のような断続変調をかけた高周波電力を用いることで、良質な膜形成に寄与するラジカルの優先生成および不必要なラジカルの抑制が可能になり、パーティクルの発生を抑制することができる。

【0037】しかも、ホルダ兼電極に上記のような負のバイアス電圧を印加することで、基体の表面近傍にできるシース領域内のイオンが膜に衝突するエネルギーを利用して、低温成膜においても、膜の結晶化を促進させることができる。その結果、多結晶膜を得るためにの後処理が不要になり、そのぶん工程を簡略化することができる。

【0038】また、非常に薄い膜の形成とそれの結晶化とが繰り返されることになるので、熱処理による結晶化に比べて、膜表面の平滑性が良好な結晶化薄膜を形成す

(4)

特開平6-291048

6

ことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の実施に用いたプラズマCVD装置の一例を示す概略図である。

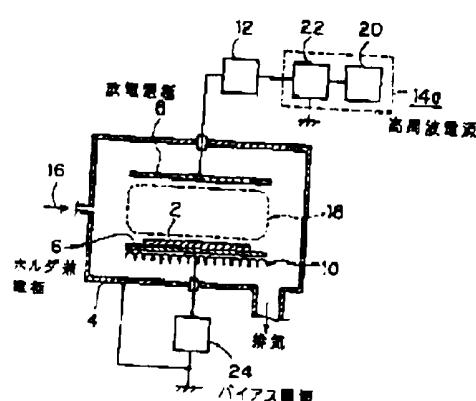
【図2】図1の装置における高周波電力とバイアス電圧の一例を示す図である。

【図3】従来のプラズマCVD装置の一例を示す概略図である。

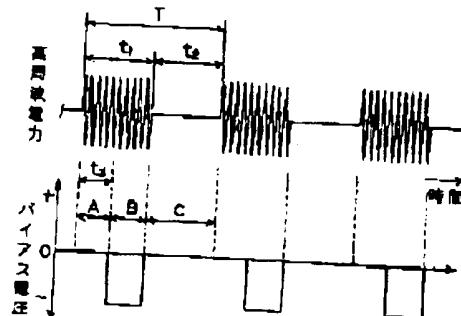
【符号の説明】

- 2 基体
- 4 真空容器
- 6 ホルダ兼電極
- 8 放電電極
- 14a 高周波電源
- 18 プラズマ
- 24 バイアス電源

【図1】



【図2】



【図3】

